

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成27年4月23日(2015.4.23)

【公開番号】特開2013-195204(P2013-195204A)

【公開日】平成25年9月30日(2013.9.30)

【年通号数】公開・登録公報2013-053

【出願番号】特願2012-62012(P2012-62012)

【国際特許分類】

G 01 N 21/65 (2006.01)

【F I】

G 01 N 21/65

【手続補正書】

【提出日】平成27年3月10日(2015.3.10)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基材と、

前記基材に配置された複数の金属微細構造と、

前記金属微細構造の表面に形成された金属膜と、を備え、

前記金属微細構造の材料と前記金属層の材料とは異なること、を特徴とする試料分析基板。

【請求項2】

請求項1に記載の試料分析基板において、

前記金属微細構造の材料が、Ag、Au、Cu、Pt、Alからなる第1群より選択される1種類の金属であって、

前記金属層の材料が、Ag、Au、Pt、Cu、Al、Cr、Ruからなる第2群の中より選択される、少なくとも1種類の金属であること、を特徴とする試料分析基板。

【請求項3】

請求項2に記載の試料分析基板において、

前記金属膜が、1層以上5層以下の積層構造であることを特徴とする試料分析基板。

【請求項4】

請求項2または3に記載の試料分析基板において、

前記金属微細構造の大きさが、50nm以上800nm以下であることを特徴とする試料分析基板。

【請求項5】

請求項2または3に記載の試料分析基板において、

前記金属膜の厚さが、0.1nm以上20nm以下であることを特徴とする試料分析基板。

【請求項6】

請求項4または5に記載の試料分析基板において、

前記金属微細構造は、真空蒸着法、電子ビーム露光法、収束イオンビーム法、干渉露光法、陽極酸化法、ナノインプリント法、電子ビーム融解法のいずれかにより形成されたことを特徴とする試料分析基板。

【請求項7】

請求項 6 に記載の試料分析基板において、

前記金属膜は、斜方蒸着法、電子ビーム露光法、収束イオンビーム法、干渉露光法、陽極酸化法、ナノインプリント法、電子ビーム融解法のいずれかにより形成されたことを特徴とする試料分析基板。

【請求項 8】

請求項 1 乃至 7 のいずれか一項に記載の試料分析基板と、

前記金属構造と前記金属膜に向けて光を放出する光源と、

前記光の照射に応じて前記金属構造と前記金属被膜から放射される光を検出する光検出器と、を備えることを特徴とする検出装置。